

**Вашему вниманию предлагается информация
о живых разработках по RET-технологии**

1. **VL029**, собранный в четырех выводной корпус, с дополнительным выводом базы выходного транзистора, по схеме (рис. 1) и с электрическими параметрами, приведенными в таблице 1.

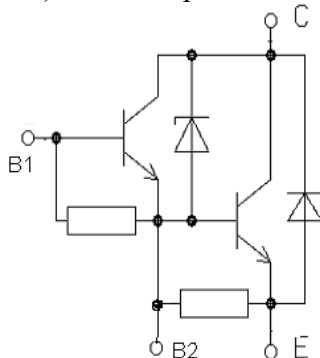


Рис.1

Транзистор по схеме Дарлингтона, предназначен для работы на индуктивную нагрузку в схемах зажигания автомобилей.

Таблица 1 Основные параметры.

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Букв.обозн.	Норма
Максимально-допустимые режимы		
1.Максимально-допустимое напряжение коллектор-эмиттер ($I_B=0$), В	$U_{КЭ\ MAX}$	350
2.Максимально-допустимое напряжение эмиттер-база , В	$U_{ЭБ\ MAX}$	5
3.Максимально-допустимый ток коллектора, А	$I_{К\ MAX}$	15
4.Максимально-допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К,И\ MAX}$	30
5.Максимально-допустимый ток базы, А	$I_{Б\ MAX}$	1
6.Максимально-допустимый импульсный ток базы, А	$I_{Б,И\ MAX}$	5
7.Максимально-допустимая постоянная мощность коллектора при температуре корпуса от минус 60 до 25 °С, с теплоотводом, Вт	$P_{К\ MAX}$	155
8.Максимально-допустимый ток диода, А	$I_{Д\ ПР}$	10
9.Максимальная рабочая температура, °С	$t_{К\ MAX}$	125
10.Минимальная рабочая температура, °С	$t_{К\ MIN}$	60
11.Предельно-допустимая температура перехода, °С	$t_{П\ MAX}$	175
Электрические параметры при $t=25\ ^\circ\text{C}$		
1.Обранный ток коллектор-эмиттер, $U_{КЭ}=350\text{ В}$, не более, мкА	$I_{КЭО}$	100
2.Обранный ток эмиттер-база, $U_{БЭ}=5\text{ В}$, не более, мА	$I_{ЭБО}$	20
3.Граничное напряжение, $I_{К}=100\text{ мА}$, в диапазоне, В	$U_{КЭО\ ГР}$	350 ÷ 520
4.Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, не более, В $I_{К}=8\text{ А } I_{Б}=0.1\text{ А}$ $I_{К}=10\text{ А } I_{Б}=0.25\text{ А}$ $I_{К}=12\text{ А } I_{Б}=0.3\text{ А}$	$U_{КЭНАС}$	1.8 1.8 2.0
5.Напряжение насыщения база-эмиттер, не более, В $I_{К}=8\text{ А } I_{Б}=0.1\text{ А}$ $I_{К}=10\text{ А } I_{Б}=0.25\text{ А}$ $I_{К}=12\text{ А } I_{Б}=0.3\text{ А}$	$U_{БЭНАС}$	2.2 2.5 2.7
6.Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, $I_{К}=5\text{ А } U_{КЭ}=10\text{ В}$, не менее	$H_{21Э}$	300
7.Прямое падение на диоде, $I_{Д}=10\text{ А}$, не более, В	$U_{Д\ ПР}$	2.5

2. **VL030**, собранный в корпус D2PAK, по схеме (рис. 2) и с электрическими параметрами, приведенными в таблице 2.

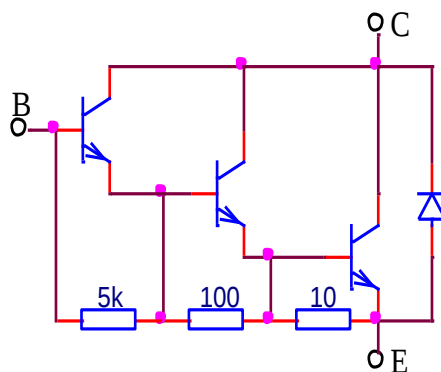


Рис. 2

Тройной транзистор по схеме Дарлингтона, предназначен для работы в схемах накачки мощных полупроводниковых лазеров и для управления электродвигателями.

Таблица 2. Основные параметры.

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Букв.обозн.	Норма
Максимально-допустимые режимы		
1.Максимально-допустимое напряжение коллектор-эмиттер ($I_B=0$), В	$U_{КЭ\text{ MAX}}$	350
2.Максимально-допустимое напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ}=1\text{ кОм}$, В	$U_{КЭ\text{ MAX}}$	500
3.Максимально-допустимое напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\text{ MAX}}$	5
4.Максимально-допустимый ток коллектора, А	$I_{К\text{ MAX}}$	20
5.Максимально-допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К,И\text{ MAX}}$	40
6.Максимально-допустимый ток базы, А	$I_{Б\text{ MAX}}$	1
7.Максимально-допустимый импульсный ток базы, А	$I_{Б,И\text{ MAX}}$	2
8.Максимально-допустимая постоянная мощность коллектора при температуре корпуса от минус 60 до 25 °С, с теплоотводом, Вт	$P_{К\text{ MAX}}$	155
9.Максимальная рабочая температура, °С	$t_{К\text{ MAX}}$	125
10.Минимальная рабочая температура, °С	$t_{К\text{ MIN}}$	60
11.Предельно-допустимая температура перехода, °С	$t_{П\text{ MAX}}$	175
Электрические параметры при $t=25\text{ °С}$		
1.Обратный ток коллектора при $U_{КЭ}=500\text{ В}$, $R_{БЭ}=1\text{ кОм}$, мкА	$I_{КЭR}$	100
2.Обратный ток эмиттер-база, $U_{БЭ}=5\text{ В}$, не более, мА	$I_{ЭБО}$	1
3.Граничное напряжение, $I_{К}=100\text{ мА}$, в диапазоне, В	$U_{КЭО\text{ ГР}}$	350
4.Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, $I_{К}=10\text{ А}$ $I_{Б}=0.01\text{ А}$, не более, В	$U_{КЭНАС}$	2.5
5.Напряжение насыщения база-эмиттер, $I_{К}=10\text{ А}$ $I_{Б}=0.01\text{ А}$, не более, В	$U_{БЭНАС}$	2.7
6.Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ, $I_{К}=10\text{ А}$ $U_{КЭ}=10\text{ В}$, не менее	$H_{21Э}$	10000
7.Прямое падение на диоде, $I_{Д}=10\text{ А}$, не более, В	$U_{Д\text{ ПР}}$	2.5